

[専門科目 (物理化学)] (全 2 題)

[問題 1] 以下の文章を読み, 問 A~G に答えよ.

図 1 の点群 C_{2h} に属する 1,3-ブタジエン分子の HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1 である分子軌道 $\phi_1 \sim \phi_4$ を, それぞれ炭素原子の $2p_z$ 原子軌道の線型結合を用いて $\phi_i = \sum_{A=1}^4 c_{iA} \chi_A$ のように記述する. ただし, χ_A は図 1 の炭素原子 C_A ($A=1 \sim 4$) の $2p_z$ 原子軌道関数を表し, $z > 0$ で正の値を, $z < 0$ で負の値をとる実関数とする. Hückel 法によると係数 c_{iA} の値は,

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ b & a & b & 0 \\ 0 & b & a & b \\ 0 & 0 & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{i1} \\ c_{i2} \\ c_{i3} \\ c_{i4} \end{pmatrix} = \varepsilon_i \begin{pmatrix} c_{i1} \\ c_{i2} \\ c_{i3} \\ c_{i4} \end{pmatrix} \quad (1)$$

なる固有方程式の固有ベクトルとして与えられる. その固有値 ε_i は式(1)から得られる永年方程式の解であり, 軌道エネルギーに対応する. ただし, a および b は負の値とする.

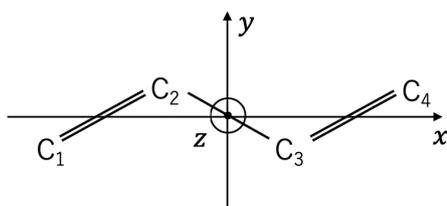


図 1 原子は全て xy 平面上にあり, 分子は原点について点対称である.

点群 C_{2h} の指標表

C_{2h}	\hat{E}	\hat{C}_2	\hat{i}	$\hat{\sigma}_{xy}$	双極子
A_g	1	1	1	1	
B_g	1	-1	1	-1	
A_u	1	1	-1	-1	z
B_u	1	-1	-1	1	x, y

- 問 A 原子軌道 χ_1 に回転操作 \hat{C}_2 を作用させて得られる $\hat{C}_2 \chi_1$ を, $\{\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4\}$ を用いて表せ.
- 問 B 点群 C_{2h} に属する対称要素 $\hat{C}_2, \hat{i}, \hat{\sigma}_{xy}$ について, $\{\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4\}$ を基底とする表現行列を次の (i) ~ (iv) からそれぞれ選べ.

$$\begin{array}{ll}
 \text{(i)} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{(ii)} : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
 \text{(iii)} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{(iv)} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

問 C Hückel 法より与えられる HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1 の軌道 $\phi_1 \sim \phi_4$ の軌道エネルギー $\varepsilon_1 \sim \varepsilon_4$ を, a および b を用いてそれぞれ表せ. 必要ならば, 問 B の表現行列(iii)を対角行列にするユニタリ変換が

$$U^T \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

により与えられることを用いてもよい. U^T は U の転置行列を表す.

問 D 分子軌道 $\phi_1 \sim \phi_4$ に対応する点群 C_{2h} の既約表現を, 指標表をもとにそれぞれ答えよ.

問 E 基底状態の電子配置から HOMO \rightarrow LUMO の 1 電子遷移により生じる励起状態について, 対応する点群 C_{2h} の既約表現を答えよ.

問 F 基底状態と前問 E の励起状態の間の遷移双極子モーメントについて, 群論的考察からゼロ (禁制) になる成分を x, y, z の中からすべて選び答えよ. 考察の過程も記すこと.

問 G Hückel 法では, 変分法から導かれる固有方程式について, 異なる原子軌道の重なり積分 $S_{AB} (\equiv \int \chi_A \chi_B d\mathbf{r}, \mathbf{r}$ は電子座標, $A \neq B$) をゼロとすることで式(1)を得る. これに対し, 隣接する軌道 ($|A - B| = 1$) について $S_{AB} = S (\neq 0)$ とし, それ以外 ($|A - B| > 1$) は $S_{AB} = 0$ とした場合に, 固有方程式から導かれる永年方程式を記せ.

[問題 2] 以下の文章を読み, 問 A~F に答えよ.

気相の H_2 分子が二つの H 原子に解離し, 金属中の空隙に侵入するとしてよう (図 1). ①気相の H_2 分子は理想気体として扱い, H_2 分子 ($\text{H}_2(\text{g})$) と金属中の H 原子 ($\text{H}(\text{s})$) には, 絶対温度 T , 圧力 p のもとで次の平衡が成り立っているとす.



式(1)の平衡下での $\text{H}_2(\text{g})$ と $\text{H}(\text{s})$ の化学ポテンシャルをそれぞれ μ_{H_2} , μ_{H} とすると, 両者の間に式(2)が成り立つ.

$$\boxed{\text{(ア)}} \quad (2)$$

金属中に N 個の空隙が存在し, そのうち N_{H} 個に H 原子が吸蔵されており, $N > N_{\text{H}} \gg 1$ である場合を考える. H 原子を吸蔵した金属の Gibbs エネルギーとエントロピーをそれぞれ G_{M} , S_{M} とすると, G_{M} の微分は

$$dG_{\text{M}} = V_{\text{M}}dp - \boxed{\text{(イ)}} + \mu_{\text{H}}dn_{\text{H}} \quad (3)$$

と表される. ただし, V_{M} は金属の体積, n_{H} は $\text{H}(\text{s})$ の物質質量である. μ_{H} は G_{M} の偏微分から

$$\mu_{\text{H}} = \boxed{\text{(ウ)}} \quad (4)$$

で与えられ, これより水素の充填率 $x_{\text{H}} = N_{\text{H}}/N$ と p の間に

$$p = \alpha(T) \cdot \left(\boxed{\text{(エ)}} \right)^2 \quad (5)$$

が成り立つことが導かれる. $\alpha(T)$ は温度に依存する関数である.

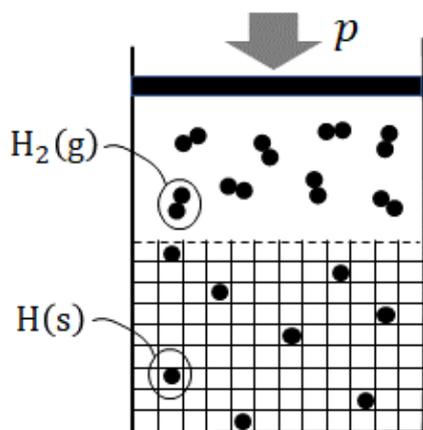


図 1 金属中への水素吸蔵の模式図
黒丸は水素原子を表し, 下部のマスは金属中の空隙を表す.

問 A 空欄 に入る μ_{H_2} と μ_{H} の間の関係式を記せ.

問 B 下線部①に注意して, μ_{H_2} を $\text{H}_2(\text{g})$ の標準化学ポテンシャル $\mu_{\text{H}_2}^\circ$, 標準圧力 p° , 気体定数 R , T および p を用いて表せ.

問 C 空欄 に入る S_{M} を用いた式を答えよ.

問 D S_{M} は, N_{H} に依存する部分 S_{H} と, N_{H} に依存しない部分に分けられる. また, S_{H} は金属中の N 個の空隙から N_{H} 個の $\text{H}(\text{s})$ 吸蔵サイトを選ぶ場合の配置エントロピーで与えられるとする. S_{H} を N_{H} , N および Boltzmann 定数 k_{B} を用いた式で表せ.

問 E H 原子を吸蔵した金属のエンタルピーを H_{M} として, 次の H_{M} の偏微分係数を

$$\left(\frac{\partial H_{\text{M}}}{\partial n_{\text{H}}}\right)_{p,T} = h_{\text{H}}$$

とおく. 問 D の結果を用いて, 空欄 に入る適切な式を h_{H} , N_{H} , N , R および T を用いて表せ. ただし正の整数 $K (\gg 1)$ について成り立つ Stirling の式

$$\ln K! \cong K \ln K - K$$

を用い, 導出の過程も記せ.

問 F 空欄 には x_{H} の関数が入る. 前問までの結果を用いて, 空欄 に入る適切な式を記せ. ただし h_{H} は p には依存しないとして, 導出の過程も記せ.